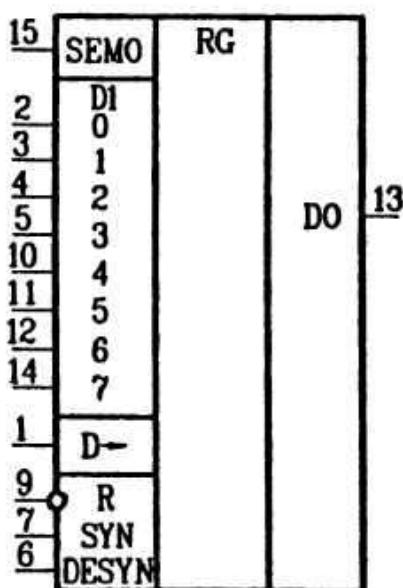


КР1533ИР10, КФ1533ИР10, ЭКФ1533ИР10

Микросхемы представляют собой 8-разрядный сдвиговый регистр с параллельной записью. Имеют 2 режима работы: параллельная загрузка и сдвиг. Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,2 г и 4307.16-А.

Назначение выводов: 1 - вход информационный 1 разряда; 2...5 - входы информационные DI0...DI3; 6 - вход блокировки синхросигнала DESYN; 7 - вход синхронизации SYN; 8 - общий; 9 - вход установки в состояние лог. 0 \bar{R} ; 10...12 - входы информационные D14...D16; 13 - выход информационный 8 разряда; 14 - вход информационный DI7; 15 - вход режима SEMO; 16 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ИР10, КФ1533ИР10, ЭКФ1533ИР10

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания 5 В ± 10%

Выходное напряжение низкого уровня при $U_n = 4,5$ В:

- при $I_{\text{вых}}^0 = 4$ мА $\leq 0,4$ В
- при $I_{\text{вых}}^0 = 8$ мА $\leq 0,5$ В

Выходное напряжение высокого уровня

при $U_n = 4,5$ В; $I_{\text{вых}}^1 = -0,4$ мА $\geq (U_n - 2)$ В

Ток потребления при $U_n = 5,5$ В ≤ 29 мА

Входной ток низкого уровня:

- по выводам 6, 7, 9, 15 $\leq |-0,1|$ мА
- по выводам 1...5, 10...12, 14 $\leq |-0,2|$ мА

Входной ток высокого уровня ≤ 20 мкА

Выходной ток	-30 ... -112 мА
Время задержки распространения сигнала при выключении:	
- от вывода 7 к выводу 13	≤ 19 нс
Время задержки распространения сигнала при включении:	
- от вывода 7 к выводу 13	≤ 17 нс
- от вывода 9 к выводу 13	≤ 21 нс
Емкость входа	≤ 5 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °C

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °C; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоеем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °C; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °C; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1

мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В $\pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.